

بررسی رفتار خوردگی پوشش تانالم لایه‌نشانی شده به روش کندوپاش مگنترونی

مصطفی علیشاھی^{۱*}، فرزاد محبوبی^۲، سید محمد موسوی خوئی^۳

۱- استادیار، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه حکیم سبزواری، سبزوار، ایران

۲- استاد، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

۲- دانشیار، دانشکده مهندسی معدن و متالورژی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

*عهده دار مکاتبات: m.alishahi@hsu.ac.ir

(تاریخ دریافت: ۱۳۹۵/۰۴/۱۷، تاریخ پذیرش: ۱۳۹۵/۰۳/۲۲)

چکیده: در این پژوهش پوشش تانالم به روش کندوپاش مگنترونی جریان مستقیم روی سیلیکون (۱۰۰) و فولاد زنگزن (۳۱۶L) لایه‌نشانی شد. خواص ساختاری پوشش تانالم به کمک آزمون پراش پرتو ایکس ارزیابی شده و از میکروسکوپ‌های الکترونی عبوری و روبشی و همچنین میکروسکوپ نیروی اتمی جهت بررسی سطح مقطع و مورفولوژی سطح پوشش استفاده شد. افزون بر این، رفتار خوردگی پوشش تانالم در مقایسه با فولاد زنگزن (۳۱۶L) به کمک آزمون پلاریزاسیون پتانسیوبدینامیک بررسی شده و از آزمون طیف‌سنجدی امپدانس الکتروشیمیابی جهت تعیین مکانیزم‌های خوردگی استفاده شد. نتایج نشان دادند که استفاده از لایه آستری نیترید تانالم، می‌تواند سبب تغییر ساختار کریستالی پوشش تانالم از مخلوط فازی α و β به ساختار تک فاز α ، و کاهش مقاومت الکتریکی پوشش از حدود ۹۰ به ۱۵ میکروآهم در سانتی‌متر شود. همچنین مطالعات میکروسکوپی نشان دادند که پوشش تانالم ساختاری ستونی و بسیار فشرده با سطحی یکنواخت و بدون عیب از خود نشان داده و زیری میانگین آن کمتر از ۶ نانومتر اندازه گیری شد. نتایج آزمون‌های خوردگی نشان داد که پوشش تانالم مانند یک سد فیزیکی از تماس محلول خورنده با زیرلایه جلوگیری کرده و بازده حفاظت بیشتر از ۷۰ درصد را سبب می‌شود. در این ارتباط، نفوذ محلول خورنده به زیرلایه از طریق حفرات راه‌باز موجود در پوشش به عنوان مکانیزم خوردگی پوشش تانالم شناخته شد و شاخص تخلخل پوشش حدود ۶ درصد تعیین شد.

واژه‌های کلیدی:

پوشش تانالم، کندوپاش مگنترونی، خوردگی، پلاریزاسیون، طیف‌سنجدی امپدانس الکتروشیمیابی، حفرات راه‌باز.

۱- مقدمه

خوردگی، مقاوم سایش، روانکار، تزیینی و یا پوشش‌هایی با خواص خاص الکتریکی و یا نوری داشته است [۱۰-۱۴]. کندوپاش مگنترونی، روشی مقرن به صرفه است که می‌تواند پوشش‌های لایه نازک را با خلوصی بالا و چسبندگی عالی روی سطح‌های بزرگ لایه‌نشانی کند [۱۱، ۴].

پوشش‌دهی سطح یکی از بهترین و اقتصادی‌ترین روش‌ها جهت افزایش مقاومت خوردگی سازه‌های فلزی در برابر محیط‌های خورنده است [۳-۱]. روش کندوپاش مگنترونی^۱ یکی از روش‌های لایه‌نشانی فیزیکی بخار (PVD)^۲ است که در دهه گذشته توسعه زیادی جهت تولید پوشش‌های سخت، مقاوم

در این پژوهش پوشش تانتالم به روش کندوپاش مگنترونی جریان مستقیم به طور همزمان روی زیرلایه سیلیکون (۱۰۰) و فولاد زنگزن L ۳۱۶ لایه‌نشانی شد. پوشش حاصل توسط میکروسکوپ الکترونی رویشی نشر میدانی (FESEM)^۴، میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM)^۵، میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM)^۶ و روش پراش پرتو ایکس (XRD)^۷ ارزیابی شد. همچنین رفتار خوردگی پوشش تانتالم در مقایسه با فولاد زنگزن L ۳۱۶ به کمک آزمون‌های پلاریزاسیون پتانسیویدنامیک (PDP)^۸ و طیف‌سنجه امپدانس الکتروشیمیایی (EIS)^۹ ارزیابی شده و بازده حفاظت پوشش محاسبه شد.

۲- مواد و روش انجام تحقیق

در این پژوهش از سیلیکون (۱۰۰) و فولاد زنگزن L ۳۱۶ به عنوان زیرلایه استفاده شد. پیش از لایه‌نشانی، زیرلایه‌های فولادی با استفاده از کاغذ سباده کاربید سیلیسیم تا درجه ۴۰۰۰ سباده خورد و سپس توسط پودر الماس، تا درجه ۰/۰۵ میکرومتر پولیش شد. هر دو نوع زیرلایه پیش از قرار گرفتن درون محفظه لایه‌نشانی، ابتدا به مدت ۱۰ دقیقه در استون و سپس ۱۰ دقیقه در اتانول تمیز کاری آلتراسونیک شده و در نهایت توسط گاز نیتروژن خشک شدند.

لایه‌نشانی پوشش تانتالم به روش کندوپاش مگنترونی جریان مستقیم از یک تارگت ۳ اینچی دایره‌ای شکل از جنس تانتالم (خلوص ۹۹/۹۵ درصد) انجام شد. در سیستم مورد استفاده تارگت تانتالم در فاصله ۱۵۰ میلی‌متری و در روبروی زیرلایه‌های متصل به زمین^{۱۰} قرار گرفت. فشار پایه در محفظه لایه‌نشانی حدود ۱۰ میلی‌بار بود و لایه‌نشانی پوشش تانتالم در فشار کاری حدود ۱۱(sccm)^{۱۱} ۱۰ × ۲/۵ میلی‌بار با شار ۲۵ سانتی‌متر مکعب بر دقیقه (sccm) گاز آرگون (خلوص ۹۹/۹۹) انجام شد. در زمان لایه‌نشانی، دمای زیرلایه توسط یک سیستم آب‌گرد در حدود ۲۰ درجه سانتی‌گراد ثابت نگهداشته شد. لایه‌نشانی پوشش تانتالم بدون اعمال بایاس به زیرلایه و به مدت ۱۲۰ دقیقه انجام شد.

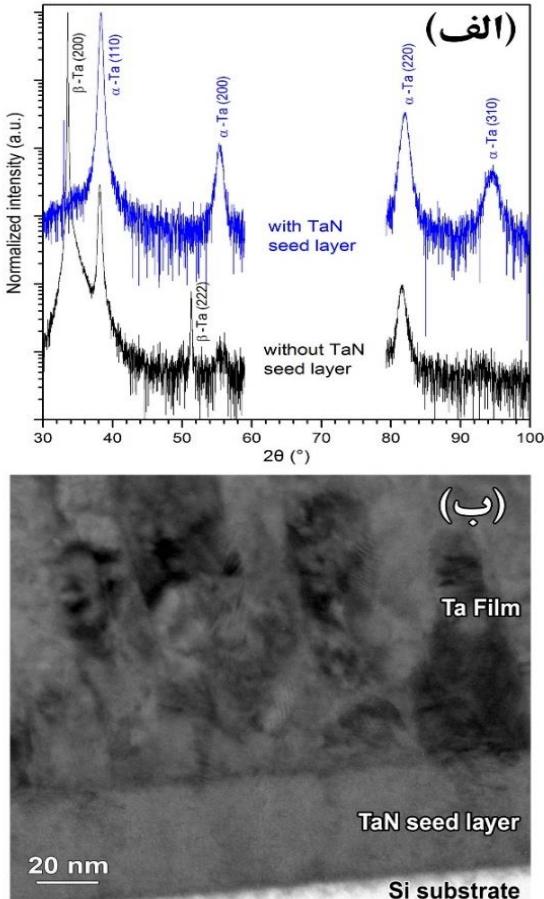
ضخامت پوشش و انحنای زیرلایه سیلیکونی توسط پروفیلومتر

تانتالم یکی از فلزات دیرگداز با دمای ذوب ۲۹۹۶ درجه سانتی‌گراد است که خواص ماشین‌کاری عالی و دمای انتقال تردی-نرمی بسیار پایین دارد [۱۲]. تانتالم دو ساختار کریستالی مشخص دارد. فاز پایدار α که ساختار bcc دارد و فاز نیمه‌پایدار β که ساختار کریستالوگرافی آن تتراگونال است. تانتالم α خواص شیمیایی، حرارتی و مکانیکی خوبی نظیر مدول الاستیک بالا در حد فولاد، نقطه ذوب بالا، فرم‌پذیری و داکتیلیتی خوب، مقاومت الکتریکی کم و همچنین مقاومت شیمیایی عالی در برابر اسیدها و گازهای خورنده دارد، در حالیکه ساختار β ، فازی ترد و شکننده با مقاومت الکتریکی بالا است که در دمای بالاتر از ۱۰۲۳ درجه کلوین به فاز α تبدیل می‌شود [۱۳].

لایه‌نشانی کندوپاش مگنترونی یکی از روش‌های متدائل برای لایه‌نشانی پوشش تانتالم و ترکیبات آن است [۱۴-۱۵]. در این ارتباط، بسته به نوع زیرلایه و شرایط لایه‌نشانی، ساختار پوشش تانتالم می‌تواند فاز α ، β و یا مخلوطی از هر دو باشد [۱۶]. با کنترل شرایط لایه‌نشانی تانتالم، بسته به کاربرد مورد نظر می‌توان پوشش‌هایی با مقاومت الکتریکی کم و یا زیاد، مقاومت سایشی و خوردگی مناسب، دمای ذوب بالا و شکل‌پذیری خوب تولید کرد [۱۷]. پوشش‌های تانتالم می‌توانند در صنایع الکترونیک [۱۸]، نظامی [۲۰-۱۹] شیمیایی [۲۱] و پزشکی [۲۲-۲۳] کاربرد داشته باشند.

مقاومت خوردگی بالای آلیاژهای پایه تانتالم عموماً به تشکیل یک لایه روین نازک، نفوذناپذیر و خشی (احتمالاً پنتوکسید تانتالم^۲، Ta_2O_5) روی سطح آنها نسبت داده می‌شود. این لایه روین بسیار نازک و بدون عیب بوده که پیوندی قوی با تانتالم برقرار کرده و در صورت صدمه دیدن می‌تواند خود را ترمیم کند [۲۴-۲۵]. با وجود اینکه مقاومت خوردگی تانتالم و ترکیبات آن در اکثر محیط‌های شیمیایی عالی است [۲۶-۲۴] و انتظار می‌رود که پوشش‌های پایه تانتالم گزینه مناسبی برای حفاظت از سازه‌های فلزی در برابر خوردگی باشند، تاکنون تحقیقات کمی در ارتباط با رفتار خوردگی این پوشش‌ها صورت پذیرفته است [۲۷-۳۰].

زنگنزن ۳۱۶L نیز مشابه با پوشش لایه‌نشانی شده روی زیرلایه سیلیکون است.



شکل (۱): (الف): اثر لایه آستری TaN بر الگوی XRD پوشش تانتالم و (ب): تصویر TEM از مقطع عرضی پوشش تانتالم و لایه آستری TaN روی زیرلایه سیلیکون

شکل (۱-ب) تصویر TEM از فصل مشترک زیرلایه سیلیکون، لایه آستری نیترید تانتالم و پوشش تانتالم را نشان می‌دهد. مشاهده می‌شود که لایه آستری نیترید تانتالم با ضخامت حدود ۵۰ نانومتر ساختار و دانه‌بندی مشخصی ندارد، در حالیکه پوشش تانتالم α ساختاری ستونی داشته که هر ستون حاوی دانه‌های مجزا با اندازه حدود ۴۰ نانومتر است. ساختار ستونی پوشش تانتالم بسیار فشرده بوده و اثربار از حفرات بین ستونی و یا سایر عیوب در آن مشاهده نمی‌شود. همچنین فصل مشترک‌ها پیوسته بوده و از کیفیت بسیار خوبی برخوردارند. هیچ اثربار از عدم اتصال و عیوب در فصل مشترک مشاهده نشده و ارتباط خوبی بین پوشش تانتالم و لایه

Dektak-150 (Veeco®) اندازه‌گیری شد. مطالعات میکروسکوپی بر روی نمونه‌ها توسط FESEM، میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM)^{۱۲} و AFM صورت پذیرفت و از XRD جهت بررسی ساختار کریستالی و محاسبه اندازه دانه پوشش استفاده شد. مقاومت الکتریکی پوشش‌ها توسط آزمون چهار پین^{۱۳} اندازه‌گیری شد. رفتار خوردگی فولاد زنگنزن ۳۱۶L پوشش تانتالم در محلول ۰.۵ M H₂SO₄ + 2 ppm HF در دمای ۰.۵ M در محیط توسط آزمون‌های PDP و EIS ارزیابی شدند. این محلول به طور رایج جهت شیوه‌سازی محیط کاری پل‌های سوتی با غشای تبادل پروتون استفاده می‌شود [۱۵]. در سلول الکتروشیمیایی مورد استفاده، نمونه الکترود کاری بوده و از یک توری پلاتینی به عنوان الکترود کمکی و یک الکترود استاندارد کالومل (SCE)^{۱۶} به عنوان الکترود مرجع استفاده شد.

۳- نتایج و بحث

۱-۱- مشخصه‌یابی پوشش تانتالم
شکل (۱-الف) الگوی XRD پوشش تانتالم لایه‌نشانی شده روی سیلیکون را نشان می‌دهد. مشاهده می‌شود که بدون استفاده از لایه آستری نیترید تانتالم، ساختار کریستالی پوشش تانتالم مخلوطی از فازهای α و β است. افزون بر این، مقاومت الکتریکی این پوشش حدود ۹۰ میکرواهم در سانتی‌متر اندازه‌گیری شد، که این مقدار بیشتر از مقاومت فاز α بوده و در تایید آزمون XRD بیان‌گر حضور فاز β در پوشش است. نتایج نشان دادند که استفاده از لایه آستری نیترید تانتالم به ضخامت حدود ۵۰ نانومتر، سبب کاهش مقاومت الکتریکی پوشش تانتالم به حدود ۱۵ میکرواهم در سانتی‌متر شد. بررسی الگوی XRD این پوشش (شکل (۱-الف)) نشان داد که اثربار از حضور فاز β در پوشش وجود ندارد و ساختار کریستالی تانتالم α در پوشش مشاهده می‌شود. ایکدا^{۱۷} و همکاران [۳۱] نشان دادند که صفحه کریستالی (۱۱۱) تانتالم α می‌تواند به صورت شبه ابی تکسیال^{۱۸} روی صفحه (۱۱۱) فاز نیترید تانتالم مکعبی (c-TaN) رشد کند. شایان ذکر است بررسی‌ها نشان داد که ساختار کریستالی پوشش تانتالم لایه‌نشانی شده روی زیرلایه فولاد

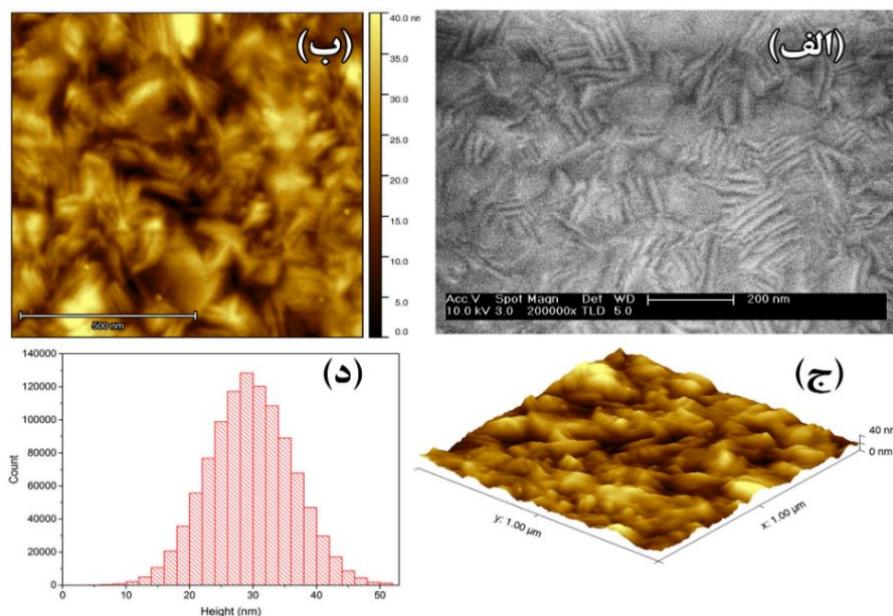
طولانی موجود در محفظه لایه‌نشانی، به بمباران پوشش در حال رشد توسط ذرات پرانرژی نسبت داده می‌شود. بمباران سطح در حال رشد پوشش توسط ذرات پرانرژی سبب تولید عیوب نقطه‌ای در پوشش و اعوجاج شبکه شده [۳۷-۳۸] و همچنین فشرده شدن ریزساختار [۳۹-۴۰] را به همراه دارد، که هر دو عامل می‌توانند تنش فشاری بوجود آورند.

شکل (۲-الف) تصویر FESEM از سطح پوشش تانتالم را نشان می‌دهد. مورفولوژی سوزنی شکل در سطح این پوشش به خوبی مشاهده می‌شود. این مورفولوژی به عنوان مشخصه پوشش تانتالم ۰ شناخته می‌شود [۴۱]. همچنین در این تصویر مشاهده می‌شود که سطح پوشش پیوسته و عاری از ترک و سایر عیوب است. این ویژگی می‌تواند در رفتار خوردگی پوشش اثر مثبت داشته باشد. بررسی مورفولوژی سطح پوشش تانتالم با AFM نشان داد که پوشش تانتالم α رفتار فراکتالی با زبری متوسط (R_a) $5/3$ نانومتر و محدود مربعات زبری (R_{rms}) $6/6$ نانومتر از خود نشان می‌دهد (شکل (۲-ب و -ج)). همچنین شکل (۲-د) نشان می‌دهد که تغییرات ارتفاع زبری در پوشش، توزیعی نرمال با بیشینه حدود ۳۰ نانومتر دارد که این امر نشان‌دهنده یکنواختی سطح پوشش است. افزون بر این، در تصویر AFM مورفولوژی سوزنی شکل پوشش به خوبی پدیدار است. در این ارتباط فاصله بین سوزنی کمتر از ۲ نانومتر اندازه گیری شد.

آستری نیترید تانتالم برقرار است. این ساختار بدون عیب و فشرده در بررسی خواص خوردگی بسیار حائز اهمیت است [۱۵]. با استفاده از رابطه شر 17 [۳۲] و تعیین عرض در نیمه ارتفاع پیک (۱۱۰) در الگوی XRD، اندازه دانه پوشش تانتالم حدود ۲۰ نانومتر محاسبه شد. اختلاف بین اندازه دانه محاسبه شده توسط رابطه شر و مقدار اندازه گیری شده در تصویر TEM (حدود ۴۰ نانومتر) ناشی از این واقعیت است که رابطه شر اندازه کریستالیت‌ها را محاسبه می‌کند ولی در تصویر TEM، دانه‌بندی پوشش مشاهده می‌شود. هر دانه مشاهده شده در تصویر TEM می‌تواند از چندین دانه فرعی یا کریستالیت تشکیل شده باشد. مقایسه موقعیت پیک‌های الگوی XRD پوشش تانتالم با نمونه مرجع بیان گر جایه‌جایی پیک‌های پوشش تانتالم به سمت زاویه‌های پراش کوچکتر است. این جایه‌جایی در موقعیت پیک‌ها را می‌توان به حضور تنش فشاری در پوشش نسبت داد [۳۲]. در این ارتباط، تنش فشاری موجود در پوشش با اندازه گیری انحنای زیرلایه سیلیکونی پیش و پس از لایه‌نشانی و به کمک رابطه استونی 18 ، اندازه گیری شد [۳۳-۳۴]:

$$\sigma = \frac{E_s h_s^2}{6rh_f(1-v)} \quad (1)$$

در این رابطه E_s و v به ترتیب مدول الاستیک و ضریب پواسون زیرلایه هستند، که این مقادیر برای سیلیکون (۱۰۰) به ترتیب برابر با 130 گیگاپاسکال و حدود 0.25 است. h_s و h_f به ترتیب ضخامت زیرلایه و پوشش هستند که مقادیر آنها به ترتیب حدود 40 میکرومتر و 96 نانومتر است. تفاوت شعاع انحنای زیرلایه پیش و پس از لایه‌نشانی را نشان می‌دهد که توسط پروفیلومتر حدود $3/4$ متر اندازه گیری شد. با انجام محاسبات، مقدار تنش پسماند پوشش تانتالم، حدود $1/4$ گیگاپاسکال اندازه گیری شد. حضور تنش فشاری در این پوشش ناشی از فشار کاری پایین مورد استفاده است که توسط مکانیزم کوبش اتمی 19 شرح داده می‌شود [۳۷-۳۵]. در این مکانیزم، وجود تنش فشاری در پوشش‌های حاصل از کندوپاش در فشار پایین، به دلیل مسیر میانگین آزاد



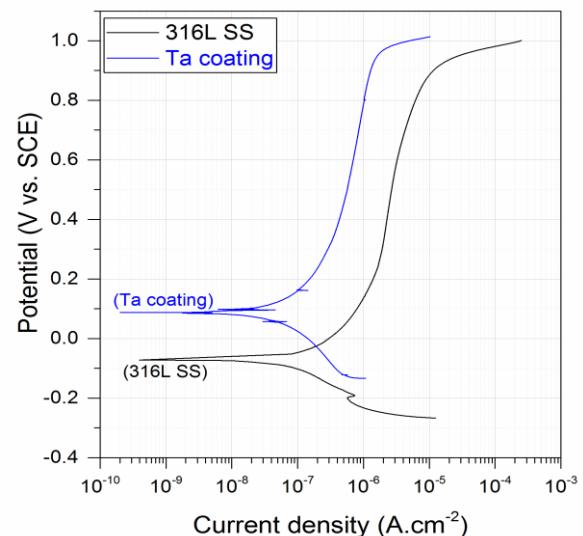
شکل (۲): تصویر: (الف): FESEM، (ب): AFM دو بعدی، (ج): AFM سه بعدی از سطح پوشش تانتالم به همراه و (د): منحنی توزیع ارتفاع زبری

این انتقال خطی و سریع از حالت فعال به روین در اثر افزایش پتانسیل بیان گر پایداری شیمیایی نمونه‌ها است [۴۲]. همچنین مشاهده می‌شود که منحنی PDP نمونه لایه‌نشانی شده به سمت پتانسیل‌های نجیب‌تر و چگالی جریان‌های کمتر جابجا شده است که به ترتیب بیان گر خشی بودن بیشتر پوشش نسبت به زیرلایه و مقاومت خوردگی بهتر پوشش از زیرلایه است. به منظور بررسی دقیق‌تر، با استفاده از منحنی‌های PDP پارامترهای الکتروشیمیایی نظیر پتانسیل خوردگی (E_{corr}) و چگالی جریان خوردگی (i_{corr})، از طریق روش برون‌یابی تافل^{۲۱} [۴۳] محاسبه و در جدول (۱) لیست شدند. همچنین با استفاده از روشی که جزیيات آن در مقاله‌ای دیگر [۴۴] شرح داده شده است، به ترتیب مقاومت پلاریزاسیون (R_p) و بازده حفاظت (P_i) محاسبه و در جدول (۱) آورده شدند.

جدول (۱) نشان می‌دهد که پتانسیل خوردگی ۸۴ میلی‌ولت SCE برای پوشش تانتالم به مراتب نجیب‌تر از پتانسیل خوردگی زیرلایه فولاد زنگ‌زن ۳۱۶L (۷۰- میلی‌ولت SCE) است. بنابراین پوشش تانتالم از لحاظ ترمودینامیکی استعداد به خوردگی کمتری نسبت به زیرلایه دارد و به صورت کاتدی از زیرلایه محافظت

۲-۳-۱-۱- آزمون PDP

شکل (۳) منحنی PDP فولاد زنگ‌زن ۳۱۶L بدون پوشش را در مقایسه با پوشش تانتالم را نشان می‌دهد.



شکل (۳): منحنی‌های PDP فولاد ۳۱۶L بدون پوشش و با پوشش تانتالم

مشاهده می‌شود که در محیط مورد مطالعه هر دونمونه به سرعت روین شده و رفتار روینگی بدون منطقه انتقالی فعل- روین دارد.

خوردگی زیرلایه را بشدت افزایش می‌دهد و سبب کاهش چگالی جریان خوردگی از 141 mV به 41 mV میکروآمپر بر سانتی‌متر مربع و همچنین افزایش مقاومت پلاریزاسیون از $281 \text{ }\mu\Omega \cdot \text{cm}^2$ به $685 \text{ }\mu\Omega \cdot \text{cm}^2$ کیلواهم بر سانتی‌متر مربع می‌شود و بازده حفاظت حدود 70 درصد را به همراه می‌آورد. مقاومت بالای پلاریزاسیون پوشش تانتالم به لایه روین اکسید تانتالم که روی سطح آن وجود دارد، نسبت داده می‌شود. این لایه روین بدون عیوب بوده و به علت ضخامت بسیار کم، تنفس پسماند ناچیزی دارد. همچنین این لایه پیوندی قوی با فلز تانتالم داشته و در صورت آسیب دیدن به طور خود به خود ترمیم می‌شود.

می‌کند. در این شرایط، در زوج گالوانیک پوشش-زیرلایه که در محل حفرات راهباز و یا در صورت آسیب دیدن و جداشدن موضعی پوشش تشکیل می‌شود، پوشش تانتالم نقش کاتد و زیرلایه نقش آند را بازی می‌کند. زیرلایه در پوشش‌های کاتدی بشدت نسبت به وجود حفرات راهباز و آسیب دیدگی موضعی پوشش آسیب‌پذیر است، زیرا در این حفرات سطح کمی از زیرلایه (آن) باید الکترون مورد نیاز برای واکنش کاتدی بر روی سطح وسیع پوشش مجاور (کاتد) را تامین کند، که این امر خوردگی شدید زیرلایه را به همراه دارد.

با بررسی جدول (۱) مشاهده می‌شود که پوشش تانتالم مقاومت

جدول (۱): پارامترهای الکتروشیمیایی بدست آمده از منحنی‌های PDP فولاد زنگ‌زن $316L$ بدون پوشش و لایه‌نشانی شده با پوشش تانتالم

P (%)	P_i (%)	R_p ($\text{k}\Omega \cdot \text{cm}^2$)	β_c (mV)	β_a (mV)	i_{corr} ($\mu\text{A} \cdot \text{cm}^{-2}$)	E_{corr} (mV)	
-	-	۲۶۱	۲۱۸	۱۹۶	0.141	-۷۰	$316L$
۶/۱۷	۷۰/۲۱	۶۸۵/۶	۱۶۲	۲۰۶	0.042	۸۴	پوشش تانتالم

در این رابطه P شاخص تخلخل، R_p^s مقاومت پلاریزاسیون زیرلایه، R_p^c مقاومت پلاریزاسیون پوشش، ΔE_{corr} اختلاف پتانسیل خوردگی و β شیب تألف آندی زیرلایه هستند. همان‌طور که در جدول (۱) آورده شده، شاخص تخلخل برای پوشش تانتالم مورد مطالعه حدود 6 درصد محاسبه شده است.

بنابراین این لایه روین می‌تواند مقاومت خوردگی بالای فلز تانتالم در محیط‌های خورنده را فراهم آورد [۲۴]. وجود این لایه روین سبب می‌شود تا پوشش تانتالم به صورت یک سد فیزیکی عمل کرده و به طور موثری از نفوذ محلول خورنده به زیرلایه جلوگیری کند. با این وجود هرگز امکان حفاظت صدرصدی برای پوشش‌ها وجود نداشته و همواره مقداری از محلول خورنده از طریق عیوب موجود در پوشش به زیرلایه نفوذ پیدا می‌کند. در این ارتباط حفرات راهباز، یکی از عیوب متداول در پوشش‌های PVD هستند که محلول خورنده می‌تواند از طریق آنها به زیرلایه دسترسی پیدا کند [۳۹]. بنابراین چگالی حفرات راهباز، تعیین کننده مقاومت خوردگی پوشش تانتالم است. در این ارتباط شاخص تخلخل P ، که با چگالی حفرات راهباز موجود در پوشش نسبت مستقیم دارد را می‌توان به روش الکتروشیمیایی و توسط رابطه (۲) محاسبه کرد [۴۵-۴۷].

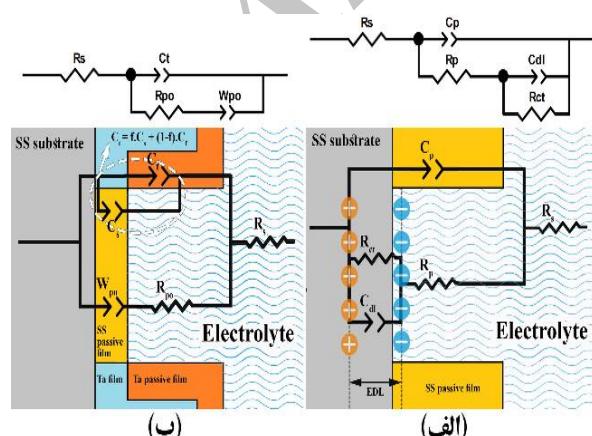
$$P = \left(\frac{R_p^s}{R_p^c} \right) \times 10^{(\frac{-|\Delta E_{corr}|}{\beta_a^s})} \quad (2)$$

۳-۲-۲-آزمون EIS
پیش‌تر اشاره شد که خوردگی فولاد زنگ‌زن $316L$ لایه‌نشانی شده با پوشش تانتالم از طریق نفوذ محلول خورنده به حفرات راهباز موجود در پوشش و خوردگی زیرلایه در این مناطق، صورت می‌پذیرد. برای تایید صحت این مکانیزم و همچنین درک بیشتر از رفتار و مکانیزم خوردگی فولاد زنگ‌زن $316L$ و پوشش تانتالم در محیط مطالعه، از آزمون EIS کمک گرفته شد. شکل (۴) رسم نایکوییست^۳ و رسم بُد^۴ حاصل از آزمون EIS برای زیرلایه و پوشش تانتالم را نشان می‌دهد.

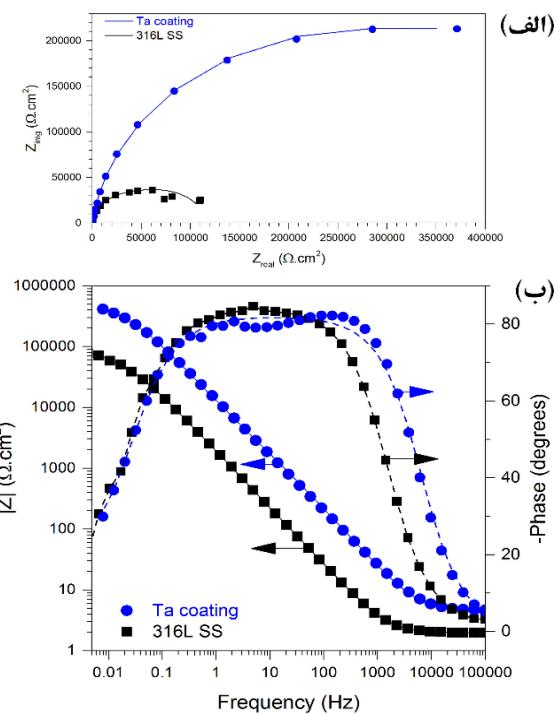
فرکانس پایین ($\tau_2 = C_{dl} R_{ct}$) به مقاومت انتقال بار و ظرفیت خازنی لایه دوگانه الکتریکی نسبت داده می‌شود [۴۹]. در این مطالعات به علت وجود انحراف از رفتار خازنی ایده‌آل در سیستم، از یک عنصر فازی ثابت (CPE) به جای خازن استفاده می‌شود. امپدانس CPE توسط رابطه (۳) بیان می‌شود.

$$Z_{CPE} = \frac{1}{Y_0(j\omega)^n} \quad (3)$$

در این رابطه Y_0 و n اعداد ثابت هستند، $j = \sqrt{-1}$ و (۳) فرکانس زاویه‌ای است. به طور رایج پوشش‌های PVD مستعد به خوردگی حفره‌ای در حفرات راهباز هستند. نفوذ محلول خورنده به درون پوشش عموماً با استفاده از اجزای وابسته به نفوذ در مدار معادل توصیف می‌شود که این اجزا فرآیند نفوذ تحت شرایط مرزی خاص را توصیف می‌کنند [۴۸]. لیو [۴۶] و همکاران [۴۸، ۵۱] گزارش داده‌اند که برای آنالیز طیف EIS پوشش‌های PVD، بسته به خواص الکتروشیمیایی زیرلایه، ریزساختار پوشش و همچنین اندازه و شکل عیوب ساختاری موجود در پوشش، مدارهای معادل مختلفی به کار برده می‌شوند. شکل (۵-ب) مدار معادل استفاده شده در این پژوهش جهت آنالیز طیف امپدانس پوشش تانتالم را نشان می‌دهد. در این مدار، C_{dl} ظرفیت خازنی کل است که در ادامه درباره آن بحث خواهد شد. R_{po} و W_{po} به ترتیب مقاومت محلول و عنصر وابسته به نفوذ در حفرات راهباز هستند.



شکل (۵): مدار معادل مورد استفاده برای آنالیز داده‌های EIS مربوط به فولاد زنگنزن ۳۱۶L: (الف): بدون پوشش و (ب): با پوشش تانتالم



شکل (۴): (الف): رسم نایکوییست و (ب): رسم بُد برای فولاد زنگنزن ۳۱۶L بدون پوشش و با پوشش تانتالم

در رسم نایکوییست (شکل (۴-الف)) مشاهده می‌شود که امپدانس حقیقی نمونه لایه‌نشانی شده با پوشش تانتالم بیشتر از فولاد زنگنزن ۳۱۶L است و در نتیجه مشابه با نتایج آزمون می‌توان بیان داشت که پوشش تانتالم مقاومت خوردگی فولاد ۳۱۶L را افزایش داده است. افزون بر این، زاویه بیشینه فاز در رسم بُد در هر دو نمونه (شکل (۴-ب)) نزدیک به $\frac{\pi}{2}$ است که بیان گر رفتار خازنی فولاد زنگنزن ۳۱۶L و پوشش تانتالم است [۴۸، ۳۰، ۲۸]. به منظور بررسی دقیق‌تر رفتار الکتروشیمیایی زیرلایه و پوشش، از دو مدار معادل موجود در شکل (۵)، جهت شبیه‌سازی فصل مشترک محلول/نمونه و آنالیز منحنی‌های EIS استفاده شد. شکل (۵-الف) متدائل‌ترین مدار معادل برای آنالیز خوردگی موضعی فولادهای زنگنزن است [۵۰-۴۹]. در این مدار R_s مقاومت محلول است و ثابت زمانی $\tau_1 = C_p R_p$ همبسته با منطقه فرکانس بالا در طیف امپدانس فولاد ۳۱۶L، به مقاومت محلول در حفرات لایه روین و ظرفیت خارنی منطقه بدون عیب لایه روین نسبت داده می‌شود. ثابت زمانی همبسته با منطقه

در این رابطه C_p ظرفیت خازنی لایه رویین فولاد زنگنزن L_{316} ، C_f ظرفیت خازنی لایه رویین پوشش تانتالم و f کسر سطحی حفرات راهباز موجود در پوشش هستند ($0 \leq f \leq 1$). داده‌های EIS بدست آمده با استفاده از مدارهای معادل معرفی شده در شکل (۴) توسط نرم‌افزار Zview/Zplot [۵۲] برآورد شدند. منحنی‌های برآورده برای زیرلايه و پوشش در شکل (۴) به صورت خط رسم شده و نتایج حاصل از برآورده در جدول (۲) آورده شده است. این جدول در تطابق با نتایج آزمون PDP نشان می‌دهد که استفاده از پوشش تانتالم سبب افزایش چشم‌گیر مقاومت خوردگی فولاد زنگنزن L_{316} شده است. همچنین با توجه به اینکه C_t برای نمونه لایه‌نشانی شده از C_p زیرلايه بیشتر است، بر طبق رابطه (۴) می‌توان بیان داشت که C_t با f متناسب است. این نتیجه از آنجا حائز اهمیت است که نشان می‌دهد پوشش با C_t کوچک‌تر چگالی حفرات راهباز کمتری دارد. بنابراین از C_t می‌توان به عنوان معیاری برای ارزیابی میزان این نوع عیوب در پوشش استفاده کرد. افزون بر این، عموماً انحراف پارامتر توانی n_t و n_{dl} از مقدار واحد را به زبری زیاد، وجود غیریکنواختی و بافت در سطح نسبت می‌دهند [۵۱، ۵۳]. در نتیجه با توجه به جدول (۲) مشاهده می‌شود که مقدار این پارامترها نزدیک به یک است و می‌توان بیان داشت که هر دونمونه سطحی یکنواخت دارند.

عنصر W_{po} ماهیت فیزیکی مشابه با CPE دارد و امپدانس آن توسط رابطه (۳) توصیف می‌شود. این عنصر، نفوذ نیمه محدود و خوردگی موضعی را توصیف کرده، و توسط وجود یک خط انتقالی در منطقه فرکانس پایین در رسم نایکوییست طیف EIS شناخته می‌شود [۴۹]. همان‌طور که در شکل (۳) نشان داده شد، فولاد زنگنزن L_{316} در محلول اسید سولفوریک رقیق رفتار رویین از خود نشان داده و در نتیجه بلافاصله پس از تماس این فولاد با محلول مورد مطالعه یک لایه رویین نازک با ثابت دی‌الکتریک بالا، روی سطح آن تشکیل می‌شود. این لایه رویین همچنین می‌تواند روی سطح فولاد زنگنزن L_{316} لایه‌نشانی شده با پوشش تانتالم، در محل حفرات راهباز تشکیل شده و علاوه بر محافظت از سطح زیرلايه بدون پوشش در این مناطق، رفتار خازنی از خود نشان دهد (شکل (۵-ب)) [۴۸]. به سختی می‌توان خواص دی‌الکتریک لایه رویین تشکیل شده روی زیرلايه (احتمالاً اسید کروم) در نقاط بدون پوشش را از لایه رویین تشکیل شده روی پوشش تانتالم (Ta_2O_5) در نقاط بدون عیوب پوشش تشخیص داد. بنابراین در مدار معادل مطابق با رابطه (۴) از عنصر C_t به جای این دو خازن استفاده می‌گردد.

$$C_t = f \cdot C_p + (1-f) \cdot C_f \quad (4)$$

جدول (۲): پارامترهای الکتروشیمیایی بدست آمده از آزمون EIS برای فولاد زنگنزن L_{316} بدون پوشش و لایه‌نشانی شده با پوشش تانتالم

χ^2	R_{ct} ($k\Omega \cdot cm^2$)	n_{dl} یا n_{po}	W_{po} یا C_{dl} ($\mu F \cdot s^{n-1} \cdot cm^{-2}$)	R_{po} یا R_p ($k\Omega \cdot cm^2$)	n_p یا n_t	C_t یا C_p ($\mu F \cdot s^{n-1} \cdot cm^{-2}$)	R_s ($\Omega \cdot cm^2$)		
$3/4 \times 10^{-10}$	$50/7$	$0/81$	$425/5$	$67/2$	$0/93$	$94/4$	2	$316L$	
$4/4 \times 10^{-10}$	-	$0/5$	$33/4$	$399/2$	$0/91$	$13/8$	$4/5$	پوشش تانتالم	

۲- فشار پایین لایه‌نشانی مورد استفاده در این پژوهش، سبب رشد ساختاری ستونی و فشرده و ایجاد تنفس پسماند فشاری حدود $1/4$ گیگاپاسکال در پوشش تانتالم شد.

۳- لایه‌نشانی پوشش تانتالم روی فولاد زنگنزن L_{316} ، بازده حفاظت خوردگی بیشتر از 70 درصد را سبب می‌شود. این مقاومت بالای خوردگی به علت تشکیل لایه رویین Ta_2O_5 روی

۴- نتیجه‌گیری

پوشش‌های تانتالم به روش کندوپاش مگترونی روی زیرلايه‌های سیلیکون (۱۰۰) و فولاد زنگنزن L_{316} لایه‌نشانی شد. براساس یافته‌های ارائه شده در این پژوهش، نتایج به شرح زیر هستند:

- استفاده از لایه آستری نیترید تانتالم سبب تغییر ساختار کریستالی پوشش تانتالم از مخلوط فازی $\alpha + \beta$ به فاز α می‌شود.

- simulation”, Applied Surface Science, Vol. 367, pp. 197-204, 2016.
- [7] R. Gago, M. Vinnichenko, R. Hübner & A. Redondo Cubero, “Bonding structure and morphology of chromium oxide films grown by pulsed-DC reactive magnetron sputter deposition”, Journal of Alloys and Compounds, Vol. 672, pp. 529-535, 2016.
- [8] H. Gao, Y. Li, C. Li, F. Ma, Z. Song & K. Xu, “Tuning the electronic properties in TaNx/Ag nanocomposite thin films”, RSC Advances, Vol. 6, pp. 30998-31004, 2016.
- [9] N. Srinatha, Y. S. No, V. B. Kamble, S. Chakravarty, N. Suriyamurthy, B. Angadi, A. M. Umarji & W. K. Choi, “Effect of RF power on the structural, optical and gas sensing properties of RF-sputtered Al doped ZnO thin films”, RSC Advances, Vol. 6, pp. 9779-9788, 2016.
- [10] D. Zheng, J. Xiong, P. Guo, S. Wang & H. Gu, “AlN-based film buck acoustic resonator operated in shear mode for detection of carcinoembryonic antigens”, RSC Advances, Vol. 6, pp. 4908-4913, 2016.
- [11] م. یاری، م. مجتهدزاده و ع. افشار، ”تأثیر زمان لایه نشانی بر خواص ساختاری و فیزیکی پوشش های کربنی لایه نشانی شده با روش کندوپاش مگنترونی“، فصلنامه فرآیندهای نوین در مهندسی مواد، دوره ۵، شماره ۲، ص. ۱۳۹۰، ۱-۱۰.
- [12] A. I. H. Committee, Properties and Selection: Nonferrous Alloys and Special-Purpose Materials, ASM International, 1990.
- [13] S. Myers, J. Lin, R.M. Souza, W. D. Sproul & J. J. Moore, “The β to α phase transition of tantalum coatings deposited by modulated pulsed power magnetron sputtering”, Surface and Coatings Technology, Vol. 214, pp. 38-45, 2013.
- [14] A. A. Al-masha'al, A. Bunting & R. Cheung, “Evaluation of residual stress in sputtered tantalum thin-film”, Applied Surface Science, Vol. 371, pp. 571-575, 2016.
- [15] M. Alishahi, F. Mahboubi, S. M. Mousavi Khoie, M. Aparicio, R. Hübner, F. Soldera & R. Gago, سطح پوشش است. این لایه به شدت در برابر اسید سولفوریک رقیق مقاوم است.
- [4] آزمون EIS نشان داد که مکانیزم خوردگی پوشش تانتالم تحت کنترل نفوذ محلول خورنده از طریق حفرات راهباز موجود در پوشش به زیرلایه است، که می‌توان آن را توسط عنصر نفوذ نیمه محدود شیوه‌سازی کرد.
- ### ۵- تشرک و قدردانی
- نویسنده‌گان با بت حمایت‌های صورت گرفته در راستای انجام این پژوهش، از رائول گاگو (موسسه علم مواد مادرید-اسپانیا)، ماریو اپاراسیو (موسسه سرامیک و شیشه-اسپانیا) و رنه هابنر (موسسه فیزیک پرتو یونی و تحقیقات مواد-آلمن) تشکر می‌کنند.
- ### ۶- مراجع
- [1] م. علیشاھی، م. ح. بینا و س. م. منیرواقفی، ”شکل و بررسی اثر درصد CNT بر رفتار خوردگی پوشش الکتروولس کامپوزیتی نیکل-فسفر-نانولوله کربنی“، فصلنامه فرآیندهای نوین در مهندسی مواد، دوره ۷، شماره ۳، ص. ۳۱-۳۸.
- [2] ر. سلیمانی گیلاکجانی، ف. محبوی و م. علیشاھی، ”بررسی رفتار خوردگی و تریبولوژیکی پوشش الکتروولس نانو کامپوزیتی-Ni-P-SiC“، اعمال شده روی سطح آلومینیم، دوره ۸، شماره ۲، ص. ۱۲۱-۱۳۹۳، ۱۱۳.
- [3] D. E. J. Talbot & J. D. R. Talbot, Corrosion Science and Technology, Second Edition, CRC Press, 2007.
- [4] P. J. Kelly & R. D. Arnell, “Magnetron sputtering: a review of recent developments and applications”, Vacuum, Vol. 56, pp. 159-172, 2000.
- [5] C. Petrogalli, L. Montesano, M. Gelfi, G. M. La Vecchia & L. Solazzi, “Tribological and corrosion behavior of CrN coatings: Roles of substrate and deposition defects”, Surface and Coatings Technology, Vol. 258, pp. 878-885, 2014.
- [6] S. S. Firouzabadi, K. Dehghani, M. Naderi & F. Mahboubi, “Numerical investigation of sputtering power effect on nano-tribological properties of tantalum-nitride film using molecular dynamics

- chemical processing industry—A critical survey”, Materials and Corrosion, Vol. 46, pp. 689-700, 1995.
- [25] P. E. Philip & A. Schweitzer, “Fundamentals of Metallic Corrosion: Atmospheric and Media Corrosion of Metals”, CRC Press, 2006.
- [26] S. D. Cramer, B. S. Covino & C. Moosbrugger, ASM Handbook Volume 13b: Corrosion: Materials, ASM International, 2005.
- [27] A. Robin & J. L. Rosa, “Corrosion behavior of niobium, tantalum and their alloys in hot hydrochloric and phosphoric acid solutions”, International Journal of Refractory Metals and Hard Materials, Vol. 18, pp. 13-21, 2000.
- [28] S. Maeng, L. Axe, T. A. Tyson, L. Gladczuk & M. Sosnowski, “Corrosion behaviour of magnetron sputtered α - and β -Ta coatings on AISI 4340 steel as a function of coating thickness”, Corrosion Science, Vol. 48, pp. 2154-2171, 2006.
- [29] S. M. Maeng, L. Axe, T. A. Tyson, L. Gladczuk & M. Sosnowski, “Corrosion behavior of magnetron sputtered α -Ta coatings on smooth and rough steel substrates”, Surface and Coatings Technology, Vol. 200, pp. 5717-5724, 2006.
- [30] A. Robin, “Corrosion behaviour of tantalum in sodium hydroxide solutions”, Journal of Applied Electrochemistry, Vol. 33, pp. 37-42, 2003.
- [31] M. Ikeda, M. Murooka & K. Suzuki, “Semi-epitaxial bcc Ta growth on metal nitride”, Japanese journal of applied physics, Vol. 41, pp. 3902, 2002.
- [32] B. Cullity, “Elements of X-ray Diffraction, 2nd”, Addison-Wesley Publishing. USA, 1978.
- [33] G. C. A. M. Janssen, M. M. Abdalla, F. Van Keulen, B. R. Pujada & B. Van Venrooy, “Celebrating the 100th anniversary of the Stoney equation for film stress: Developments from polycrystalline steel strips to single crystal silicon wafers”, Thin Solid Films, Vol. 517, pp. 1858-1867, 2009.
- [34] G. G. Stoney, “The Tension of Metallic Films Deposited by Electrolysis”, Proceedings of the Royal Society of London A: Mathematical, Physical
- “Electrochemical behavior of nanocrystalline Ta/TaN multilayer on 316L stainless steel: Novel bipolar plates for proton exchange membrane fuel-cells”, Journal of Power Sources, Vol. 322, pp. 1-9, 2016.
- [16] L. Gladczuk, A. Patel, C. Singh Paur & M. Sosnowski, “Tantalum films for protective coatings of steel”, Thin Solid Films, Vol. 467, pp. 150-157, 2004.
- [17] K. Tillmann, A. Thust, A. Gerber, M. P. Weides & K. Urban, “Atomic structure of Beta-tantalum nanocrystallites”, Microsc Microanal, Vol. 11, pp. 534-544, 2005.
- [18] E. Mastropaolo, R. Latif, E. Grady & R. Cheung, “Control of stress in tantalum thin films for the fabrication of 3D MEMS structures”, Journal of Vacuum Science & Technology B, Vol. 31, pp. 06FD02, 2013.
- [19] S. W. Myers, “Investigation of the beta to alpha phase transition of thick tantalum coatings deposited by modulated pulsed power magnetron sputtering”, thesis, Ann Arbor, United States, 2012.
- [20] D. W. Matson, E. D. McClanahan, S. L. Lee & D. Windover, “Properties of thick sputtered Ta used for protective gun tube coatings”, Surface and Coatings Technology, Vol. 146, pp. 344-350, 2001.
- [21] H. Yu, L. Yang, L. Zhu, X. Jian, Z. Wang & L. Jiang, “Anticorrosion properties of Ta-coated 316L stainless steel as bipolar plate material in proton exchange membrane fuel cells”, Journal of Power Sources, Vol. 191, pp. 495-500, 2009.
- [22] V. H. Pham, S. H. Lee, Y. Li, H. E. Kim, K. H. Shin & Y. H. Koh, “Utility of tantalum (Ta) coating to improve surface hardness in vitro bioactivity and biocompatibility of Co-Cr”, Thin Solid Films, Vol. 536, pp. 269-274, 2013.
- [23] M. Roy, V. K. Balla, S. Bose & A. Bandyopadhyay, “Comparison of Tantalum and Hydroxyapatite Coatings on Titanium for Applications in Load Bearing Implants”, Advanced Engineering Materials, Vol. 12, pp. B637-B641, 2010.
- [24] U. Gramberg, M. Renner & H. Diekmann, “Tantalum as a material of construction for the

- “Effect of nitrides on the corrosion behaviour of 316L SS bipolar plates for Proton Exchange Membrane Fuel Cell (PEMFC)”, International Journal of Hydrogen Energy, Vol. 40, pp. 3359-3369, 2015.
- [45] J. Creus, H. Mazille & H. Idrissi, “Porosity evaluation of protective coatings onto steel, through electrochemical techniques”, Surface and Coatings Technology, Vol. 130, pp. 224-232, 2000.
- [46] I. M. Notter & D. R. Gabe, “Polarisation resistance methods for measurement of the porosity of thin metal coatings”, Corrosion Science, Vol. 34, pp. 851-870, 1993.
- [47] F. C. Walsh, C. Ponce de León, C. Kerr, S. Court & B. D. Barker, “Electrochemical characterisation of the porosity and corrosion resistance of electrochemically deposited metal coatings”, Surface and Coatings Technology, Vol. 202, pp. 5092-5102, 2008.
- [48] C. Liu, Q. Bi, A. Leyland & A. Matthews, “An electrochemical impedance spectroscopy study of the corrosion behaviour of PVD coated steels in 0.5 N NaCl aqueous solution: Part I. Establishment of equivalent circuits for EIS data modelling”, Corrosion Science, Vol. 45, pp. 1243-1256, 2003.
- [49] J. C. Galván, M. T. Larrea, I. Braceras, M. Multigner & J. L. González-Carrasco, “In vitro corrosion behaviour of surgical 316LVM stainless steel modified by Si⁺ ion implantation – An electrochemical impedance spectroscopy study”, Journal of Alloys and Compounds, Vol. 676, pp. 414-427, 2016.
- [50] J. Flis & A. Gajek, “Impedance parameters of nitrided 304L stainless steel in an acidified sulphate solution”, Journal of Electroanalytical Chemistry, Vol. 515, pp. 82-90, 2001.
- [51] C. Liu, Q. Bi, A. Leyland & A. Matthews, “An electrochemical impedance spectroscopy study of the corrosion behaviour of PVD coated steels in 0.5 N NaCl aqueous solution: Part II.: EIS interpretation of corrosion behaviour”, Corrosion Science, Vol. 45, pp. 1257-1273, 2003.
- [52] ZPlot®/ZView™(version 3.3f), A software for EIS measurements and data analysis written by D. and Engineering Sciences, Vol. 82, pp. 172-175, 1909.
- [35] F. M. d'Heurle, “Aluminum films deposited by rf sputtering”, Metallurgical and Materials Transactions B, Vol. 1, pp. 725-732, 1970.
- [36] G. Abadias, L. E. Koutsokeras, P. Guerin & P. Patsalas, “Stress evolution in magnetron sputtered Ti-Zr-N and Ti-Ta-N films studied by in situ wafer curvature: Role of energetic particles”, Thin Solid Films, Vol. 518, pp. 1532-1537, 2009.
- [37] H. Windischmann, “Intrinsic stress in sputter-deposited thin films”, Critical Reviews in Solid State and Materials Sciences, Vol. 17, pp. 547-596, 1992.
- [38] G. Abadias, W. P. Leroy, S. Mahieu & D. Depla, “Influence of particle and energy flux on stress and texture development in magnetron sputtered TiN films”, Journal of Physics D: Applied Physics, Vol. 46, pp. 055301, 2013.
- [39] D. M. Mattox, Handbook of physical vapor deposition (PVD) processing film formation, adhesion, surface preparation and contamination control, Noyes Publications, Westwood, N. J., 1998.
- [40] Y. G. Shen, Y. W. Mai, D. R. McKenzie, Q. C. Zhang, W. D. McFall & W. E. McBride, “Composition, residual stress, and structural properties of thin tungsten nitride films deposited by reactive magnetron sputtering”, Journal of Applied Physics, Vol. 88, pp. 1380, 2000.
- [41] A. A. Navid & A. M. Hodge, “Controllable residual stresses in sputtered nanostructured alpha-tantalum”, Scripta Materialia, Vol. 63, pp. 867-870, 2010.
- [42] H. Koivuluoto, J. Näkki & P. Vuoristo, “Corrosion properties of cold-sprayed tantalum coatings”, Journal of Thermal Spray Technology, Vol. 18, pp. 75-82, 2009.
- [43] E. McCafferty, “Validation of corrosion rates measured by the Tafel extrapolation method”, Corrosion Science, Vol. 47, pp. 3202-3215, 2005.
- [44] S. Pugal Mani, A. Srinivasan & N. Rajendran,

Johnson, Scribner Associates Inc, Southern Pines, NC (USA), Copyright© 1990-2013 (<http://www.scribner.com>)).

- [53] M. Alishahi, S. M. Monirvaghefi, A. Saatchi & S. M. Hosseini, “The effect of carbon nanotubes on the corrosion and tribological behavior of electroless Ni-P-CNT composite coating”, *Applied Surface Science*, Vol. 258, pp. 2439-2446, 2012.

۷- پی‌نوشت

- [1] Magnetron sputtering deposition
- [2] Physical vapor deposition
- [3] Tantalum pentoxide
- [4] Field-emission scanning electron microscopy
- [5] Transmission electron microscopy
- [6] Atomic force microscopy
- [7] X-ray diffraction
- [8] Potentiodynamic polarization
- [9] Electrochemical Impedance Spectroscopy
- [10] Grounded substrate
- [11] Standard cubic centimeters per minute
- [12] Transmission electron microscopy
- [13] Four-point probe
- [14] Standard calomel electrode
- [15] Ikeda
- [16] Pseudo-epitaxially
- [17] Scherrer
- [18] Stoney equation
- [19] Atomic peening mechanism
- [20] Root mean square roughness
- [21] Tafel extrapolation method
- [22] Porosity index
- [23] Nyquist
- [24] Bode
- [25] Constant phase element
- [26] Liu

Corrosion behavior of magnetron sputtered tantalum coating

Mostafa Alishahi^{*1}, Farzad Mahboubi², Seyed Mahmoud Mousavi Khoie³

- 1- Assistant Professor, Faculty of Engineering, Hakim Sabzevari University, Sabzevar, Iran
2- Associate professor, Amirkabir University of Technology, Department of Mining and Metallurgical Engineering, Tehran, Iran
3- Professor, Amirkabir University of Technology, Department of Mining and Metallurgical Engineering, Tehran, Iran

*Corresponding author: m.alishahi@hsu.ac.ir

Abstract

In this study, tantalum (Ta) thin film was deposited on Si (100) and 316L stainless steel (SS) substrates by DC magnetron sputtering. The structural properties of Ta film were investigated by X-ray diffraction analysis. In addition, the scanning and transmission electron microscopies as well as atomic force microscopy were used to study the cross-section and the morphology of the coating. The corrosion behavior of the bare and Ta-coated 316L SS was evaluated by potentiodynamic polarization test. The electrochemical impedance spectroscopy was employed to study the corrosion mechanisms. The results revealed that the structure of Ta coating on either Si and SS substrates is a mixture of $\alpha+\beta$ phases, while pre-deposition of a thin tantalum nitride seed layer causes to the deposition of pure α -Ta and decreases the sheet resistance from $90 \mu\Omega\cdot\text{cm}$ to $15 \mu\Omega\cdot\text{cm}$. Microscopic evaluations show that the Ta coating is compact, homogeneous and defect-free, exhibiting a columnar structure with a surface roughness of less than 6 nm. Furthermore, the corrosion studies show that the Ta coating act as a physical barrier between corrosive electrolyte and substrate and, in this way, provide a protective efficiency of more than 70%. In this regard, the diffusion of corrosive electrolyte toward the substrates through open porosities was found to be the corrosion mechanism of the Ta coating and the porosity index of the coating was calculated to be about 6%.

Keywords:

Tantalum Coating, Magnetron Sputtering, Corrosion, Polarization, Electrochemical Impedance Spectroscopy, Open Porosities.

Journal homepage: ma.iaumajlesi.ac.ir

Please cite this article using:

Mostafa Alishahi, Farzad Mahboubi, Seyed Mahmoud Mousavi Khoie, Corrosion behavior of magnetron sputtered tantalum coating, in Persian, New Process in Material Engineering, 2018, 12(2), 139-151.